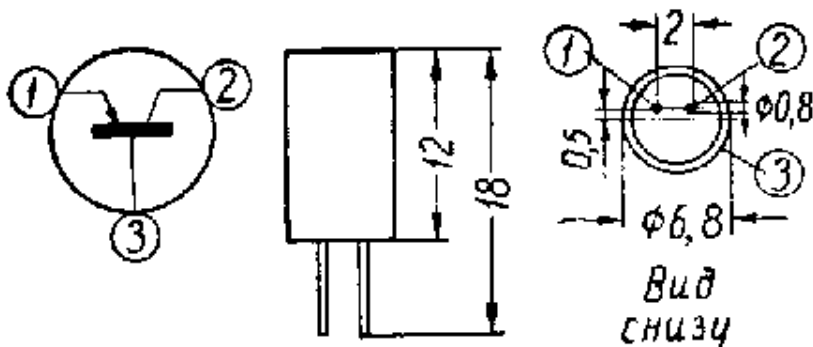


C1A, C1Б, C1В, C1Г, C1Д, C1Е, C2А, C2Б, C2В, C2Г

Германиевые усилительные (C1) и генераторные (C2) низкочастотные точечные p-n-p транзисторы.



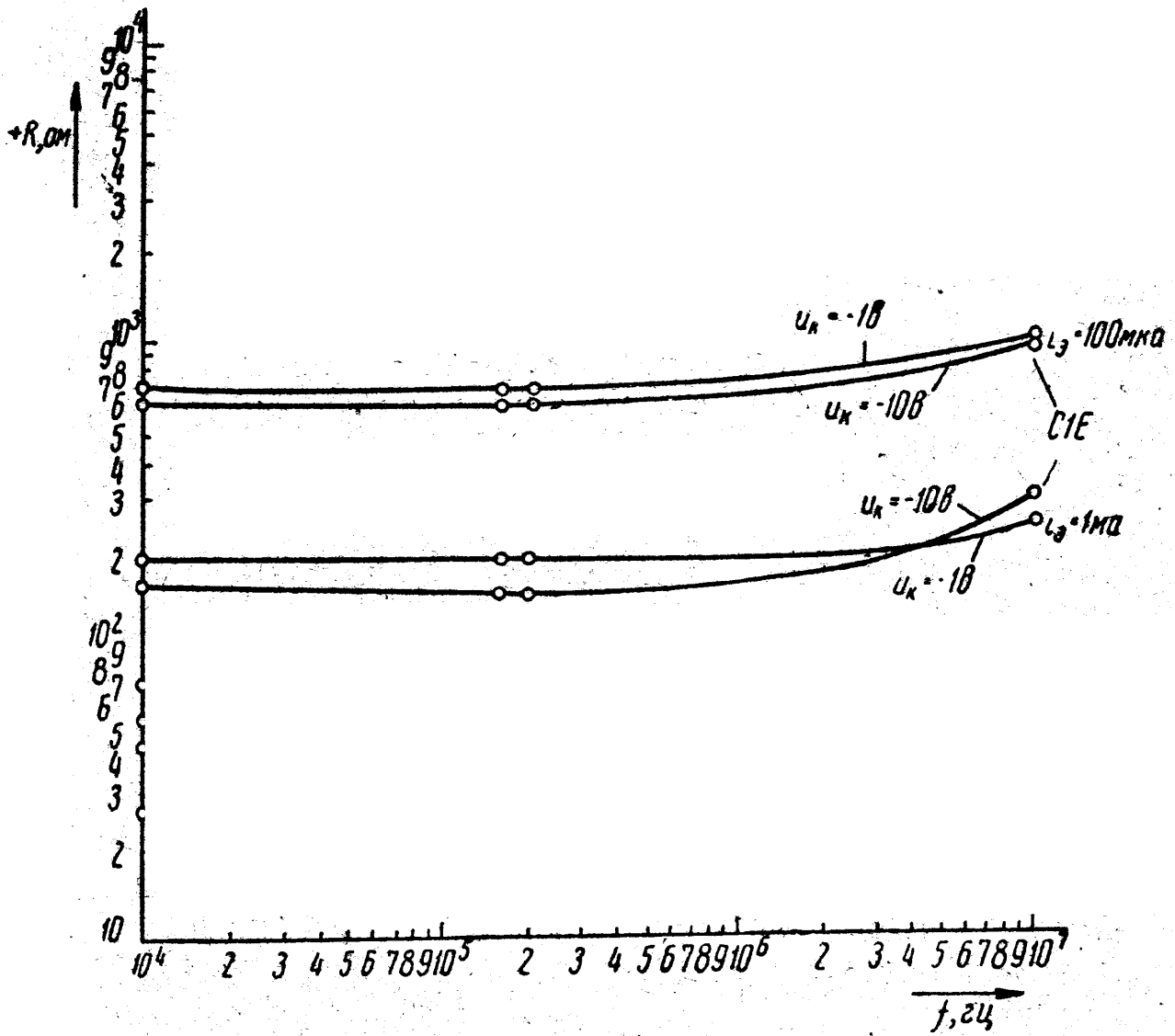
Номинальные электрические данные (в схеме с общей базой)

Коэффициент передачи тока	
C1A	> 1,2
C1Б – C1Е, C2А	> 1,5
C2Б – C2Г	> 1,6
Модуль коэффициента передачи тока	
C1А, на частоте 0,5 МГц	1,0
C1Б, C2А, на частоте 0,5 МГц	1,2
C1В, C1Г, на частоте 1,5 МГц	1,2
C1Д, на частоте 5,0 МГц	1,2
C1Е, на частоте 10,0 МГц	1,2
C2Б, на частоте 1,5 МГц	1,5
C2В, на частоте 5,0 МГц	1,5
C2Е, на частоте 10,0 МГц	1,5
Коэффициент усиления по мощности при $I_{\text{э}} = 0,3 \text{ мА}$; $U_{\text{к}} = 20 \text{ В}$	
C1А, C1В	15...19 дБ
C1Б, C1Г	18...22 дБ
C1Д	15...22 дБ
C1Е	> 15 дБ
Коэффициент усиления по напряжению	
C1Б, C1Г	> 50
C1Д	> 30
Входное сопротивление r_{11}	
C1А – C1Е	< 750 Ом
C2А – C2Г	< 1500 Ом
Сопротивление обратной связи r_{12}	
C1А – C1Е	< 200 Ом
C2А	< 700 Ом
C2Б – C2Г	< 1000 Ом
Выходное сопротивление r_{12}	> 7 Ом

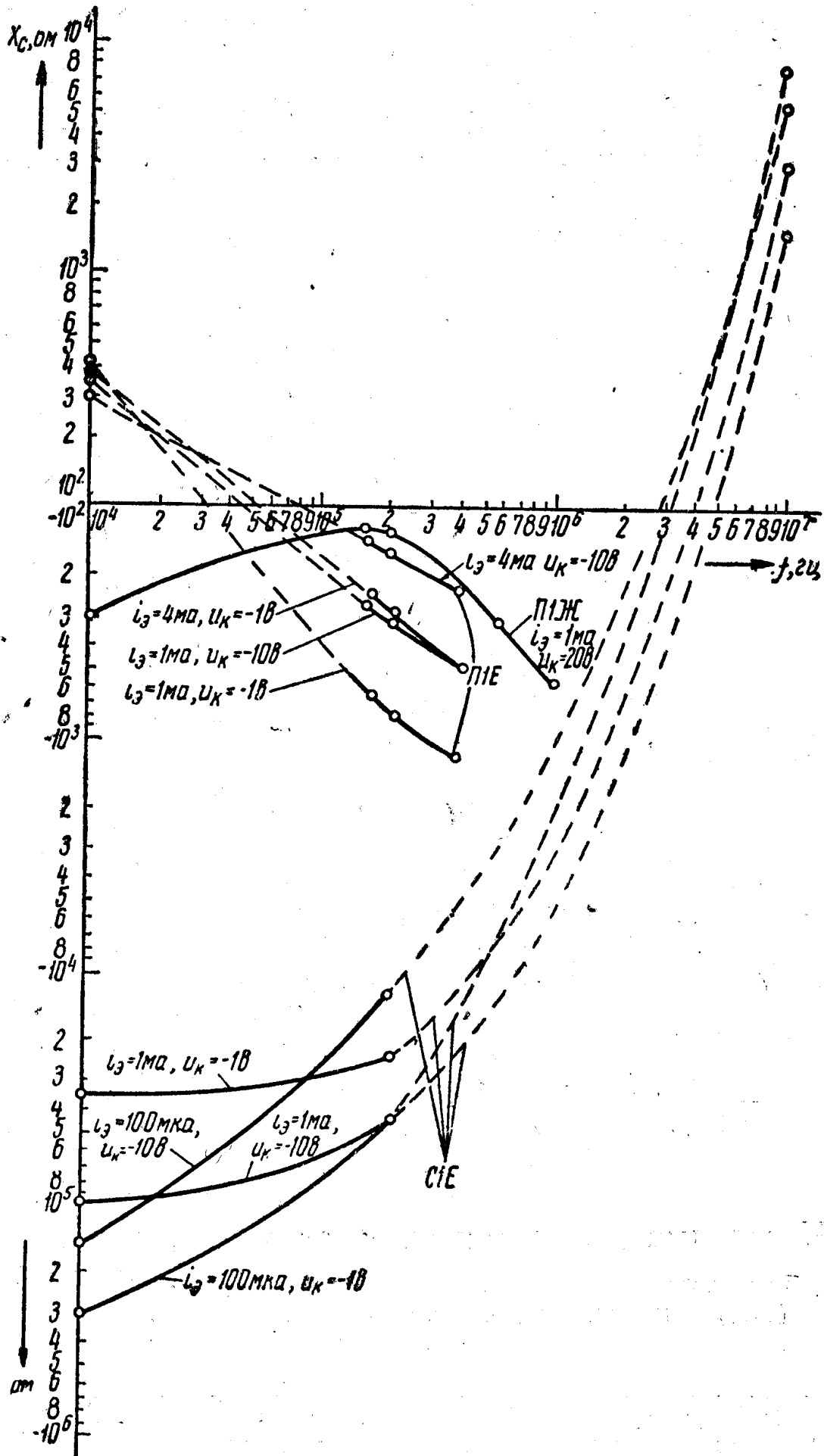
Предельно допустимые электрические величины

Ток коллектора	
C1А, C1В, C2А	10 мА
C1Б, C1Г – C1Е, C2Б – C2Г	6 мА
Ток эмиттера	10 мА
Напряжение на коллекторе	
C1А – C1Е	40 В*
C2А	30 В*
C2Б – C2Г	20 В*
Наибольшая рассеиваемая мощность	
C1А, C1В, C2А	100 мВт**
C1Б, C1Г – C1Е, C2Б – C2Г	50 мВт**
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-50...+60 °С (по некоторым источникам -50...+40°С)
Наибольшая перегрузка при вибрации	6 g
Постоянные ускорения	до 20 g
Одиночные удары	до 100 g
*при $T_{\text{окр}} > 40^\circ\text{C}$ снижается до 15-20 В	
**при $T_{\text{окр}} > 40^\circ\text{C}$ снижается до 30-50 мВт	

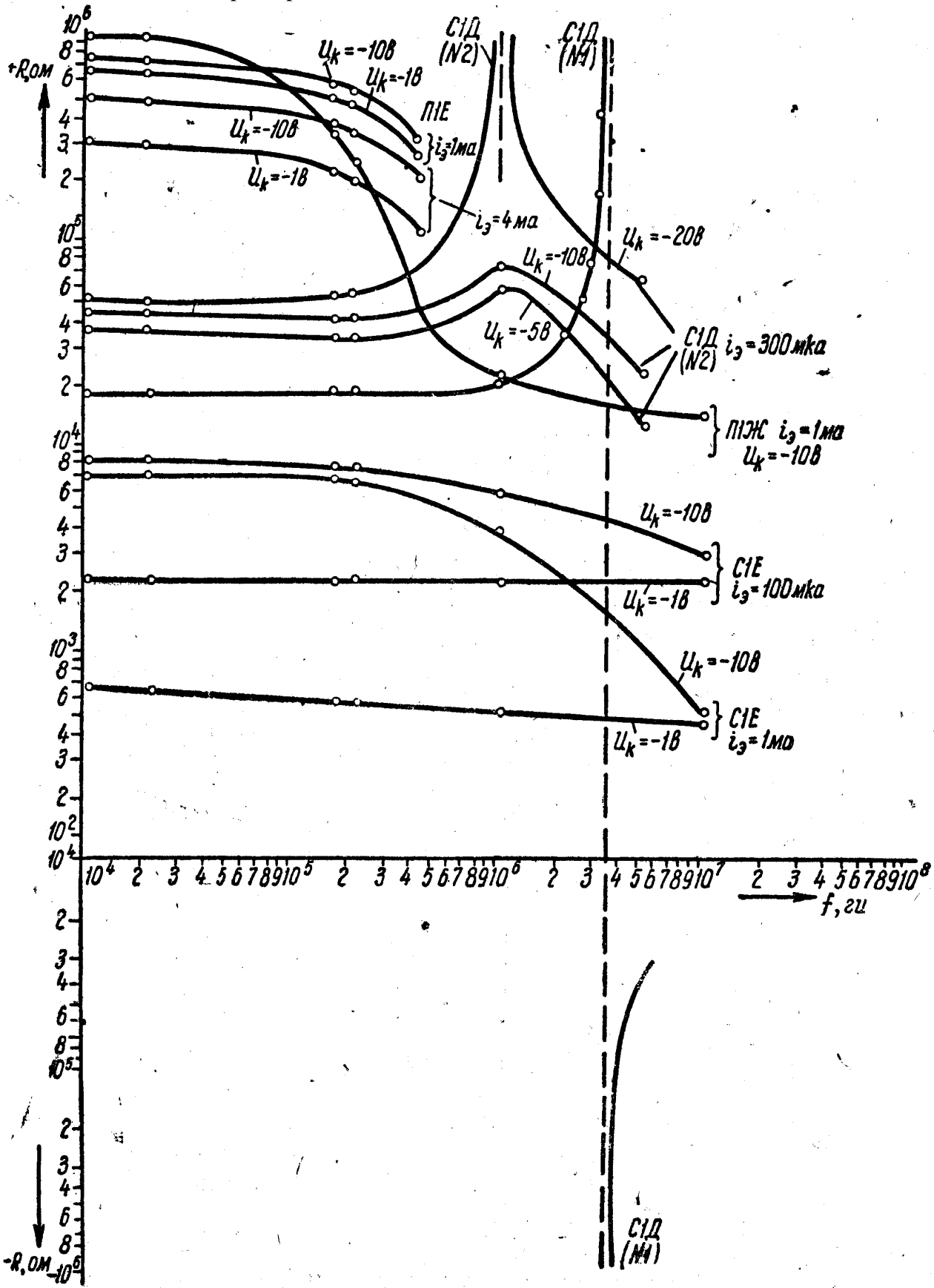
Частотные характеристики активной составляющей входного импеданса



Частотные характеристики реактивной составляющей входного импеданса



Частотные характеристики активной составляющей выходного импеданса



Частотные характеристики реактивной составляющей выходного импеданса

